

Название журнала	<b>НАНОТЕХНОЛОГИИ: РАЗРАБОТКА, ПРИМЕНЕНИЕ - XXI ВЕК</b>				
Издательство	Издательство "Радиотехника"				
Год выпуска	<b>2014</b>	Том	<b>6</b>	Номер выпуска	<b>2</b>



Название статьи	Страницы
<b>ПОЛУИЗОЛИРУЮЩИЕ 6H-SiC ПОДЛОЖКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ</b> <i>Лебедев А.А., Белов С.В., Лебедев С.П., Литвин Д.П., Никитина И.П., Васильев А.В., Макаров Ю.Н., Нагальюк С.С., Смирнов А.Н., Попов В.В., Вьюгинов В.Н., Шифман Р.Г., Кузьмичев Ю.С., Травин Н.К., Венедиктов О.В.</i>	4-10
<b>ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОДЛОЖЕК КАРБИДА КРЕМНИЯ</b> <i>Попов В.В., Вьюгинов В.Н., Травин Н.К.</i>	12-14
<b>ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНЫХ НАНОДИОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ ИНВАЗИВНЫХ БИОСЕНСОРНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ</b> <i>Иванов Ю.А., Гудков А.Г., Мешков С.А., Шашурин В.Д., Клевцов В.А., Агасиева С.В., Снякин В.Ю.</i>	15-20
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗКИ МОНОКРИСТАЛЛОВ КАРБИДА КРЕМНИЯ</b> <i>Попов В.В., Вьюгинов В.Н., Травин Н.К.</i>	22-25
<b>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ</b> <i>Стрельченко С.С.</i>	26-31
<b>ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ P-I-N-СТРУКТУР GAAS-ALGAAS ДЛЯ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ</b> <i>Крюков В.Л., Крюков Е.В., Меерович Л.А., Стрельченко С.С., Титивкин К.А.</i>	32-36
<b>ОДНОЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНЗИСТОР ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО КРЕМНИЯ НА ИЗОЛЯТОРЕ</b> <i>Преснов Д.Е., Амионов С.В., Власенко В.С., Крупенин В.А.</i>	37-41
<b>АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ МАЗЕЙ С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ</b> <i>Рахметова А.А., Богословская О.А., Семкина О.А., Овсянникова М.Н., Ольховская И.П., Глуценко Н.Н.</i>	43-48